

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 011.17049 A

(43) Date of publication of application: 09.05.89

(51) Int. CI

H01L 23/34 H01L 21/52 H01L 23/36

(21) Application number: 62273041

(22) Date of filing: 30.10.87

(71) Applicant:

HITACHI LTD

(72) Inventor:

OGURO TAKAHIRO

DOI HIROAKI

(54) INTEGRATED CIRCUIT ELEMENT COOLING DEVICE

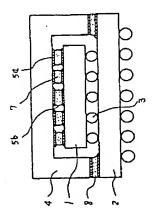
(57) Abstract:

PURPOSE: To alleviate thermal stress applied to solder balls and to allow an amount of heat generated by an integrated circuit element to be conducted to a sealing cap with high efficiency, by joining the rear face of the integrated circuit element to the inner face of the sealing cap with their joined faces being divided closely by a bonding material having high heat conductivity.

CONSTITUTION: An integrated circuit element 1 is packaged on an electrical circuit board 2 by means of solder balls 3. A sealing cap 4 is provided so as to cover the element 1, while the rear face of the element 1 and the inner face of the cap 4 are joined to each other while they are divided closely by means of a bonding material having high heat conductivity 7. Any thermal stress generated by difference in coefficient of thermal expansion of various material for example among the cap 4, substrate 2 and the element 1 is not directly applied to the balls 3 but alleviated by the bonding layer 7. Accordingly, an amount of heat generated by the

element 1 can be conducted to the cap 4 very efficiently.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio



A partial English-language translation of 1-117049

As shown in Fig. 1, Fig. 2, and Fig. 3, the semiconductor integrated circuit cooling apparatus of the invention includes metalized layers 5a and 5b on the inner surface of sealing cap 4 and the back surface of the chip 1, respectively. The metalized layers 5a and 5b are provided as a finely partitioned square or circular lattice, and are situated to face each other. The substrate 2 for mounting the chip thereon and the sealing cap 4 are made of ceramic. In particular, the sealing cap 4 needs to have both high heat conductivity and high electrical insulating property. To this end, high heat conductivity aluminum nitride (AIN) or high heat conductivity SiC with Be input are used. When the sealing cap 4 is hermetically connected to the substrate 2 by use of solder, the sealing cap 4 and the chip 1 may be bonded together by melting the solder layer 7 that is deposited on each partitioned metalized layer 6 in advance. Because of this, the hermetic sealing solder 8 for the sealing cap 4 and the bonding solder 7 for the chip 1 and the sealing cap 4 are preferably the same solder.

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

四公開特許公報(A) 平1-117049

@Int_CI_1

識別記号

厅内整理番号

母公開 平成1年(1989)5月9日

H 01 L 23/34 21/52 23/36

A-6835-5F A-8728-5F

D-6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

集積回路索子冷却装置

②特 顧 昭62-273041

多出 願 昭62(1987)10月30日

砂発 明 老 大

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研

究所内

四発 明 土 居

昭

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研

究所内

株式会社日立製作所 切出 願 人

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

20代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

1. 発明の名称 集積回路素子冷却装置

2. 特許請求の範囲

- 1. 少なくとも一つ以上の集積回路素子チップを 低気配線基板上に半田ポールによつて実装し、 上記集稜回路溝子チツブを覆うように封止キヤ ップによって気密封止する銀稜回路寿子冷却装 輝において、集積回路崇子チツブ背面と封止キ ヤツブ内面とを互いに高熱伝導性接合材によつ て、細かく分割して接合したことを特徴とする 集積回路素子冷却裝置。
- 3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はコンピュータなどに装備される集積回 路粜子の冷却装置の改良に係り、特に集積回路索 子の接続部にかかる熱応力を観和すると共に、袋 稜回路索子封止用高熱伝導性キヤツブと集稜回路 森子との接合を常に安定に保つための手段を具備 した集積回路崇子用冷却裝置に関する。

【従来の豊曜】

第6図は従来の集積回路崇子用冷却装置の構成 を示す契部側断面図である。同図に示すように、 集積回路滑子(以下チツブと称する) 1 は、基板 2 に半田ポール3 によつて電気的接続と、機械的 接続が行われ、封止キヤンプ4をかぶせ気密封止 が行われている。一般に、対止キヤツブ4,抜板 2, チツブ1は、各々熱膨脹係数が異なるため、 チツプ1が発熱すると、各部に熱応力が発生する。 半田ボールの外径は、約100μm程度と数細な ので、半田ポール3に蚤ができるだけ加わらない ようにするため、チツブ1の背面と封止キャップ 4内面との間に小さな隙間が設けられている。 し かし、熱応力級和の点で優れているが、チップ1 から発生する熱は、封止キヤツブに伝わりにくい 構造になつている。従つて、チップの発熱量は、 冷却性能上制限されてしまう。

そこで、特関昭57-21845 号公報に記載されて いる集積回路素子の冷却構造が提挙されている。 この場合、第5図の構造に対して、チップ1の背 面と封止キヤンプ4の内面が、高熱伝導性接着材 あるいは半田などによつて互いに接合されている。 しかし、チンプ1は封止キヤンプ4に固着される ので、チップ接続用半田ポール3に熱応力が直接 加わつてしまう。チンプ1の熱は封止キヤンプ4 に良好に伝わるが、半田ポール3の接続寿命は著 しく低下してしまう。また、チツプ背面のように ある程度の大きさの接合面積になると、接合層内 には、不確定な大きさの気泡が混入してしまう。 必ずしも決つた大きさの気泡が混入するわけでな いため、せつかく高熱伝導性の接着材や半田など によつて、チップとキャップを接合しても、接合 層の熟抵抗はばらついてしまう。 近年、 集積回路 素子の集積度が著しく増大しているため発熱量も 数十分にも遠する。わずか0.1 七/分の熟抵抗 が生じても、チツブの温度は数度も変動してしま

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、上記従来の集積回路素子用冷却 装置の場合は、半田ボールに加わる熱応力を積和 (3)

されているわけでないので、封止キヤツプや基 板及びチツプなどの材料の熟膨脹率の違いによつ て発生する熱応力は、すべて半田ボールに加わら ず、細かく分割した接合層によつて緩和される。

また、細かく分割したメタライズ層によつて、 接合層の大きさは規定され、接合層は細かく分散 されるので、接合層に気泡が混入せず、接合層の 熟紙抗の変動は無視できるほど小さく押えること ができる。更に、チンプから接合層にあるいは接 合層から封止キヤツブに、熱が伝わる際発生する 熱伝導収縮熱抵抗や拡大熱抵抗も非常に小さく押 えることができる。

(実施例)

以下、本発明の実施例を第1図~第3回の図面に基づいて詳細に説明する。

第1回は本発明による集積回路森子用冷却装置の一実施例を示す要部値断面図、第2回は第1回の対止キャンプ内面の正面図である。なお、第1回。第5回と同一部分に同一符号を付して説明するものである。

しながら、かつチンプの熱を効果的に対止キャンプに伝えることができない。また、たとえ、熱を良く導くためにチンプと対止キャンプとを互いに接合すると、接合層内に気密が残存し、残留気泡の大きさは必ずしも決つた大きさにならず、接合層の熱抵抗は増大し、その増加量も安定しない間間があった。

本発明の目的は、熱応力級和と冷却性能向上, 及び冷却性能の安定を间時に違成する象積回路素 子の冷却装置を提供することにある。

(問題点を解決するための手段)

かかる目的達成のため、本発明は、チップ背面と対止キャップ内面にある決まつた大きさで、細かく分割したメタライズ層を設け、両者メタライズ層を互いに向かい合わせになるように配置し、かつチップと封止キャップをハンダ等の高熱伝導 性接合材によつて互いに接合するものである。

(作用)

このように構成されたものは、チップと封止キャップ間の隙間をハンダ等によつて全面的に接合(4)

第1図と第2図、第3図に示すように、本発明 の集積回路素子用冷却装置は、チップ1の背面及 び封止キヤツブ4の内面の半田接合面上に、細か く分割した正方形あるいは円形の格子状のメタラ イズ廻5a.5bが互いに向かい合う位置に設け られている。なお、チツブ搭載用の基板2及び封 止キヤツブ4はセラミツク類である。特に、封止 キヤツブ4は高熱伝送性と電気摘殺性を共に党ね 借えて持つことが必要である。このため高熱伝導 性窓化アルミ(AAN)あるいはBe入力の高熱 伝導性SiCが用いられる。封止キャップ4を共 板2に半田によつて気密封止する際、封止キヤツ プ4とチップIとは、あらかじめ各分割メタライ ズ暦6に迎え半田をした半田暦7を溶解すること によつて接合することができる。このため、封止 キヤツブ4の気密封止用半田8と、チツブ1と封 止キヤツブ4との接合半田7とは同一のものを用 いる方が好ましい。 _

又、第4図に示す他の実施例においては、第1 図の実施例に示すセラミツク製封止キヤツブの代





特開平 1-117049(3)

りにセラミンクの体態限率の値に近い、 CuーW、CuーM。、コパール、 4 2 アロイ、インパータなどの金属材料を封止キヤンプ材に選んだ場合を示すものである。 金属製封止キヤンプの場合、半田付けを容易にするため封止キヤンプ4 の内面に NiーAuなどのメンキを行つた後、第5 図に示すように多角形、 あるいは円形状に半田付け部9 をくり抜いた格子部10にPIQなどの半田付け防止用のレジスト膜を設けている。

(発明の効果)

上記のとおり、本発明によれば、集積回路素子は、対止キャップにより外部環境から保護され、確実に対止されると共に、半田ポールに加わる熱応力を穏和させながら、かつ集積回路素子の発熱量を対止キャップに効率良く伝えることができる。また、集積回路素子と封止キャップとを細かく分割して接合するので、接合層内に接合時に混入する気泡が残存することができる。

4. 図面の簡単な説明

(7)

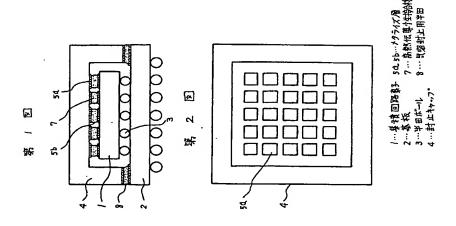
第1 図は本発明の実施例を示す要部側断面図、第2 図、第3 図は夫々封止キャップ内面のメタラクズ層の形状を示す正面図、第4 図は本発明の他の実施例を示す要部側断面図、第5 図は封止キャップ内面のレジスト層の形状を示す正面図、第6 図は従来の集積回路素子冷却装置を示す要部側断面図である。

1 … 集積回路 満子、 2 … 配線 基板、 3 … 半田ポール、 4 … 封止キヤツプ、 5 … メタライズ層、 7 … 高熱伝導性接合材、 1 0 … レジスト層。

代理人 弁理士 小川勝



(8)



--259---

